

ПРИБОРЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Осциллирующие переходные токи в PbSnTe:In в бесфоновом режиме

А. Н. Акимов, А. Э. Климов, И. Г. Неизвестный, Н. С. Пащин, В. Н. Шерстякова, В. Н. Шумский 83

Влияние размеров поперечного сечения мезатензорезисторов на их характеристики

В. А. Гридчин, А. С. Черкаев, М. А. Чебанов, В. Б. Зиновьев, И. Г. Неизвестный, Г. Н. Камаев 89

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ

Исследование радиационного поведения ячеек энергонезависимой электрически перепрограммируемой памяти на самоформирующихся проводящих наноструктурах. I. Режим хранения информации

В. М. Мордвинцев, А. В. Согоян, С. Е. Кудрявцев, В. Л. Левин 98

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ

Моделирование процессов формирования наноструктур при распылении поверхности ионной бомбардировкой

А. С. Рудый, А. Н. Куликов, А. В. Метлицкая 109

Оптимизация томографического алгоритма реконструкции плазменных неоднородностей в технологических реакторах микроэлектроники

А. В. Фадеев, К. В. Руденко, В. Ф. Лукичев, А. А. Орликовский 119

СХЕМОТЕХНИКА

Новое схемотехническое решение одноразрядного полного КМОП-сумматора

В. В. Шубин 130

Двойной балансный смеситель на МОП-транзисторах

А. С. Коротков 140

Subthreshold Schmitt Trigger Using Body-Bias Technique for Ultra Low Power and High Performance Applications

Vandana Niranjana, Maneesha Gupta, Chanchal 154

Вниманию авторов

159
